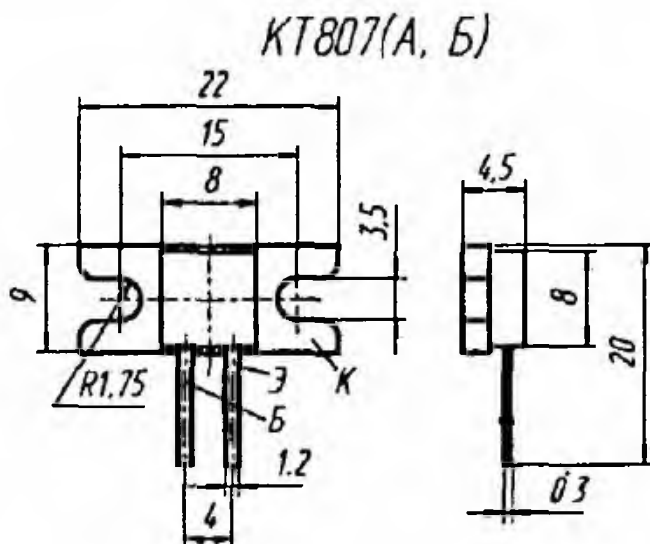


КТ807А, КТ807Б, КТ807АМ, КТ807БМ

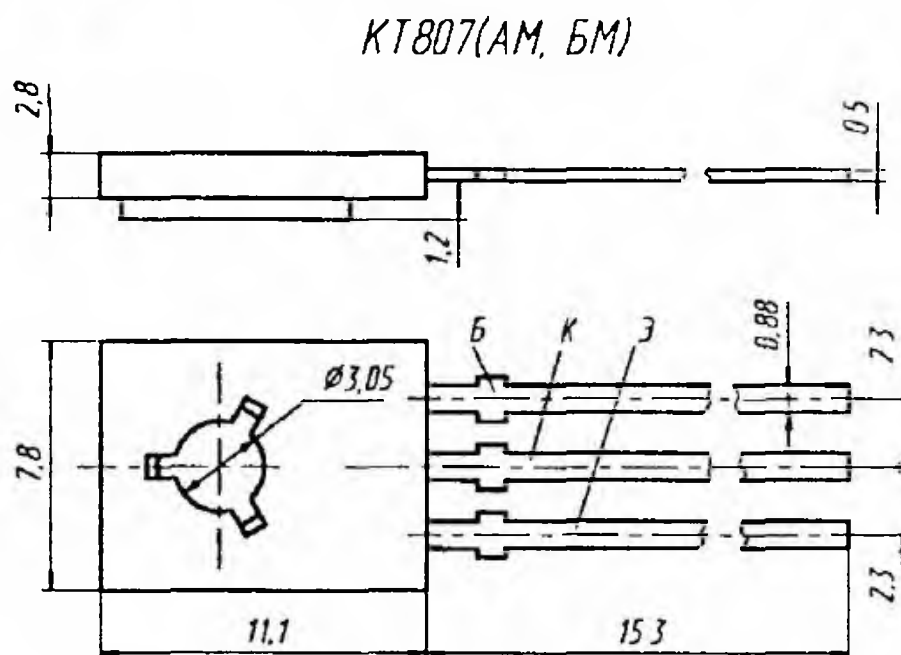
Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *n-p-n* универсальные. Предназначены для применения в генераторах кадровой и строчной разверток, усилителях низкой частоты, источниках вторичного электропитания. Выпускаются в металл-пластмассовом (КТ807А, КТ807Б) и пластмассовом (КТ807АМ, КТ807БМ) корпусах с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.



КТ807БМ) корпусах с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзисторов КТ807А, КТ807Б не более 2,5 г, КТ807АМ, КТ807БМ — не более 1 г.

Изготовитель — акционерное общество «Элиз», г. Фрязино.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 5$ В, $I_K = 0,5$ А:

$T = +25$ °С:

КТ807А, КТ807АМ 15...45

КТ807Б, КТ807БМ 30...100

$T = +85$ °С:

КТ807А, КТ807АМ 20...60

КТ807Б, КТ807БМ	45...150
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ, не менее	5 МГц
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_K = 0,5$ А, $I_E = 0,1$ А, не более	1 В
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{КЭ} = 100$ В, $R_{БЭ} = 10$ Ом, не более:	
$T = +25$ °С	5 мА
$T = +85$ °С	15 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 4$ В, не более	15 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ Ом или $R_{БЭ} = 1$ кОм и запирающем напряжении эмиттер—база 0,5 В	100 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	4 В
Импульсное напряжение коллектор—эмиттер	120 В
Постоянный ток коллектора	0,5 А
Импульсный ток коллектора при $t_n \leq 1$ мс, $Q \geq 2$	1,5 А
Постоянный ток базы	0,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T = -40...+70$ °С	10 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус	8 °С/Вт
Температура р-п перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	-40...+85 °С

¹ При $T_K > +70$ °С мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{K \text{ макс}} = (150 - T_K) / R_{T(p-K)}, \text{ Вт.}$$

Расстояние от корпуса транзистора до начала изгиба и пайки вывода не менее 5 мм. Радиус изгиба 1,5...2 мм. Пайка выводов должна осуществляться при температуре не более +250 °С в течение не более 3 с.